This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03187186

PUBLICATION DATE

15-08-91

APPLICATION DATE

18-12-89

APPLICATION NUMBER

01327901

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: MATSUOKA TOMIZO;

INT.CL.

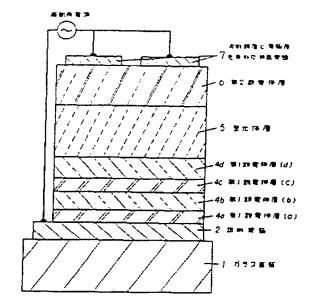
: H05B 33/02 H05B 33/26

TITLE

THIN FILM ELECTROLUMINESCENCE

DEVICE CONTAINING LIGHT

INTERFERENCE FILTER



ABSTRACT: PURPOSE: To efficiently take out brightness from a fluorescent layer from a light emitting face by making a constitution wherein voltage is applied to a laminated structure comprising a fluorescent body or the fluorescent layer and a dielectric layer.

> CONSTITUTION: A transparent electrode 2 is formed on a glass substrate 1, a first dielectric layer (a)4a and a first dielectric layer (b)4b are formed, and again the same thin dielectric films are laminated in the sequence of a first dielectric layer (c)4c and a first dielectric layer (d)4d, wherein a fluorescent layer 5 is further formed on it, and a thin dielectric film is formed as a second dielectric layer 6 to form a back plate 7 serving both as a reflection mirror layer and an electrode layer. Thus an electroluminescence EL device provided both with an electroluminescence and a light interference multilayer film filter is formed. Thus a means functioning similarly to a Fabry-pe \(\) rot interferometer is provided in the thin film EL device. Thus light of desired luminescent wavelength emitted from a luminescent center in the fluorescent layer can be efficiently taken out from a display surface so that luminous efficiency of 10 times or larger can be obtained.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

訂正有り

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出類公開

❷ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-187186

(5) Inf. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

(4)公開 平成3年(1991)8月15日

H 05 B 33/02 33/26 6649-3K 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

光干渉フイルタを含む薄膜エレクトロルミネセンス装置

创特 願 平1-327901

@出 頤 平1(1989)12月18日

四発 明 者

鉢 造

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

@発 明 者

图 松 宫

大阪府門真市大字門真1006番地

创出 頤 松下電器産業株式会社

桑

70ft 理 人 弁理士 粟野 重建 外1名

田

明

1. 発明の名称

光干渉フィルタを含む確腹エレクトロルミネモ ンス装置

2. 特許請求の範囲

(1) 光透過性を有する電極層と光反射電極層によ り、蛍光体層あるいは蛍光体層と誘電体層の積層 構造体に電圧が印加されるように構成されるとと もに、前記蛍光体層あるいは前記蛍光体層と誘電 体層の積層構造体内における、光の取出側に、前 配蛍光体層より放射される発光波長の任意の波長 入を選択的に透過する多層膜の光干渉フィルタを 前記誘電体層に屈折率の低い誘電体膜1と短折率 の高い誘電体膜2を交互に 2/4 = 膜厚・頭折率 の式に従って誘電体膜2、誘電体膜1の順に2層 以上積層し、さらに誘電体膜1より高い屈折率を 有する蛍光体層を入/2・N(Nは1以上の整数) 一膜厚・屈折率の式に従って積層し、さらに誘電 体膜3を1/4・正数-設算・屈折率の式に従っ て誘電体膜3を積層した構成にしたことを特徴と

する光干砂フィルタを含む薄膜エレクトロルミネ センス装置。

② 誘電体層として可視域において超折率が2以 上の値を持つペロブスカイト影酸化物あるいはタ ンタル酸化物と可視域において屈折率が1以上2 未満の酸窒化物を用いることを特徴とする糖求項 (1)記載の光干渉フィルタを含む強酸エレクトロル ミネセンス装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野・

本発明は、薄膜エレクトロルミネセンス装置に 関し、特に、OA機器の情報端末に用いられる薄 型平板ディスプレイへの利用等に通している。

従来の技術

薄膜エレクトロルミネセンス (以下薄膜ELと 略す)装置を用いたディスプレイとして以下に示 すような構成が提案されている。第2回は、発光 体層 5 の両側に誘電体層 4 、 6 を設け、さらにそ れを透明電腦2と背面電極7で挟み込んだ構造を している。発光体層5として緑色発光する2nS

特閒平3-187186 (2)

: Tb, F、黄橙色発光する ZnS: Mnを用いた薄膜 B L ディスプレイがある。いづれも、発光の取出は、透明電極が設けられた側のガラスの面より行っており、発光中心より放出される光強度の約10%以下しか取り出せていない。

これは、フレネルの法則に従っており、蛍光体 層内の発光中心より放出される光が発光体層と誘 電体層あるいは透明電極層の界面で反射してしま う量が90%以上あることを要している。言い換え れば、発光波長に対する全反射角が約25度と大変 狭いためである。

一方、幅広い発光波長を持つ光波の波長選択を 行うためにファブリー・ペロー型干渉計を用いる ことが知られている。このファブリー・ペロー型 干渉計は、第3回に示すように2枚の反射鏡 B を 平行に配置し、この両間隔を L とし、反射鏡内の 波数を g とするときの光の干渉条件である

L・q = K・π (πは円周率) という条件を満足する光だけがこの干渉計を透過する。但し、Kは、正の整数である。ここで同図 (a)は空気間隙の場合、同図(b)は透明固体間隙の場合を示す。実際には反射鏡の反射率Rが大きくなると第4回のように光のスペクトルの半値幅は、狭くなることがわかっている。同図(a)はファブリ・ペローの干渉計における光の行路を示す図であり、同図(b)は反射面の間隔Lまたは入射角Qを変えたときの透過率の変化(D=0.98-Rのとき)を示す図である。同図においてKは波数、Dは透過率、Rは反射率を示す。これに関しては常田光一署レーザー物理入門(1983年4月22日、岩波書店発行)の51頁から56頁に記載されている。

またさらに、この干渉計の中にレーザー媒体を 挿入するとレーザー共振器となることも知られて いる。

一方、繰り返し多層膜ではさまれた瑠膜の干渉 (いわゆる、多層膜光干渉フィルタ)は、第5図 に示した構造をしているが、この様な構造を持ち しかも高い反射層を背面にもつ弾膜の干渉特性は、 第6図に示したように前述のファブリー・ペロー 干渉計と同様の効果が得られることが明らかにさ

れている。これは、短折率の異なる光学部膜を発 光波長 A に対し反射防止の条件(n・d・(1/ 4+m/2)・ A;nは囲折率、dは膜厚、m= 0.1.2…)を摘たす膜厚で積層し、形成され る。このことに関しては例えば、腹原史朗切光学 薄膜(1985年2月25日、共立出版株式会社発行) の30 頁から34 頁中98 頁から129 頁に記載されている。

発明が解決しようとする課題

常に大きな問題点である。

課題を解決するための手段

本発明は、このような問題点を解決するために、 先透過性を有する電極層と光反射電極層により、 蛍光体層あるいは蛍光体層と誘電体層の積層構造 体に電圧が印加されるように構成されるとともに、

作用

上記標成によれば、 譲渡 P L 装置内にファブリー・ペロー光干渉計と同様の作用をする手段を設けたことになり、 蛍光体層より自然放出される光がこの干渉計により任意の発光被長に対して、 方向が揃えられて取り出せる。 従って、 蛍光体層内の発光中心から放出される所望の発光被長の先を

効率良く表示面から取り出せるので、所望の発光 被長に対する発光効率が10倍以上の値が得られる。 また、多層膜光干渉フィルタの構成をこのように 限定し蛍光体層に有効に電界が印加できるように なる。

実施例

本発明の一実施例を図に基づいて説明する。第 1 図は、本発明の薄膜エレクトロルミネセンス装置の基本構成断面図である。

ガラス基板1の上に透明電極2を成膜し、その上に、発光波長に対する屈折率n1が2.4程度で誘電率e1、膜厚d1の第1誘電体層(a)4aとして成膜する。次に、この上に、屈折率n2が1.5程度の光学薄膜(例えば、MgP2(n1-1.38)、SiO2(n1-1.52))を膜厚d2で第1誤電体層(a)4bとして成膜し、再び第1院電体層(a)と同じ誘電体薄膜を第1誤電体層(c)4cとして順に積層し、再び屈折率n2で膜厚d2の第1誘電体層(a)4dを順に積層し、さらにこの上に、配折率n3が2.4程度で膜厚d3の世光体層5を成膜し、

屈折率n4の値がn3に似かよった2.4 ±0.2 程度の競厚d4の誘電体薄膜を第2誘電体層6として成膜し、反射線層と電極層を兼ねた背面電極7を形成する。ここで、第1誘電体層(a)、(b)、(c)、(d)と蛍光体層と第2誘電体層の発光波長 10に対する屈折率n1とn2とn3とn4は、エリブソメータによって測定した。さらに、それぞれの誘電体層の膜厚d1、d2、d4と蛍光体層の膜厚d3は多層膜光干渉フィルタの設計法に従って、

$$n i \cdot d i = \lambda 0 / 4$$
 ...(1)

(i - 1, 2)

$$n \cdot 3 \cdot d \cdot 3 = \lambda \cdot 0 / 2 \cdot N \qquad ... (2)$$

$$n 4 \cdot d 4 = \lambda 0 / 2 \cdot N \qquad \cdots (3)$$

(Nは、正数 (1、2、3…))

なる式が満足されるように決定された。

すなわち、エレクトロルミネセンスと光干効多層 膜フィルタを兼ね備えたEL素子を形成したこと になる。

この第1図に示した本発明の一実施例の薄膜 P. L.装置の電圧一輝度特性は、第8図のようになり、 蛍光体層からの輝度を発光面より効率的に取り出せることができることが確かめられた。

さらに、蛍光体層に用いる蛍光体材料としては、 主な発光波長が580 nmで、黄橙色に発光する2 nS:Mnのほかに、主な発光波長が544 nmで 緑色発光するZnS:Tb. Fあるいは、ZnS :Tb.P、主な発光波長が650 nm近傍で赤色 発光するCaS:Eu、あるいはZnS:Sm、 480 nm近傍で青色発光するSrS:Ce、ある いは ZnS: Tmを用いた。また、各調 1 試 筐体 層向、向、向、向、知、第2誘電体層としては、酸化 イットリウム膜、酸化タンタル膜、酸化アルミニ ウム膜、酸化けい素膜、窒化けい素膜や、チタン 酸ストロンチウム膜で代表されるペロプスカイト 形酸化物調電体膜やタンタル酸パリウム膜等のな かから発光波長に対する屈折率を考慮にいれ選択 して用いた。第1表に本発明に用いた設置体験の 特性を示した。

(以下氽白)

第1表

構成材料	絶縁破壊 電界強度	比铁電率	n *
SiO2 AI203 T=205 NIO2 Y2O3 SI-O-N Si3N4 PbTiO3 a-BaTiO3+* SrTiO3 Ba(Sn.Ti)O3 Sr(Zr,Ti)O3 BaTa206 PbNb206	62522~~ 0.~~~ 0.~~~ 1.5 055 055 075 075 077 075	3.9 8.5 25 16 ~ 14 4 6.8 30 ~ 200 10 ~ 40 20 ~ 16 20 ~ 16 20 ~ 16 20 ~ 60	1.53 -1.53 -2.2.05 -2.2.55 -2.2.55 -2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

n * は、可視域(550 n m 近傍)の歴折率、 * * は、アモルファスのチタン酸パリウム。

また、実施した本発明の誘電体層と蛍光体層の 膜厚の決定は、発光被長 A O と、エリブソメータ 中光の透過率の測定により決定された誘電体層と 蛍光体層の発光被長に対する風折率 n の値を用い で第(1)、(2)、(3)式より決定された。

本発明により所望の発光波長をもつ高発光効率 の確認をし装置が製造できることを確認した。

素子の例の斯面構造図、第8図は、本発明の一実 施例の薄膜BL装置の輝度一電圧特性図である。

1 ····· ガラス蒸板、2 ····· 透明電極、4 a ····· 第一読電体層(a)、4 b ·····・第 1 読電体層(b)、4 c ·····・第 1 読電体層(c)、4 d ·····・第 1 読電体層(d)、 5 ······ 蛍光体層、6 ·····・第 2 誘電体層、7 ·····反 射鏡層と電極層を兼ねた背面電極。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか 1名

この時、選択する発光波長の半値幅を狭くした ほうが発光効率の増加が顕著に現れた。さらに、 光干渉多層膜フィルタを用いた反射鎮層の反射率 を発光を取り出す例として背面電極の反射率に比 べて低く設定した。

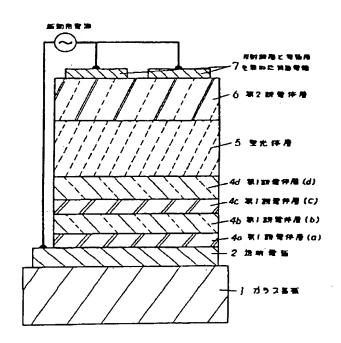
発明の効果

木発明によれば、高い発光効率で所望の発光波 長で発光する環膜エレクトロルミネセンス装置が でき、OA機器用端末、テレビジョン用画像表示 装置、ピューファインダ装置としてのフルカラー フラットディスプレイが実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の薄膜エレクトロルミネセンス装置の基本構成断面図、第2図は、従来例である薄膜とし素子の断面構造図、第3図は、ファブリー・ペロー型干渉計の構成図、第4図は、ファブリー・ペロー型干渉計の動作展理説明図、第5図は、多層膜光干渉フィルタの基本特性図、第7図は、多層膜光干渉フィルタを挿入した薄膜とし

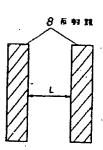
第 1 四



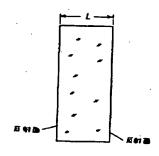
特別手3-187186 (5)

第 3 四

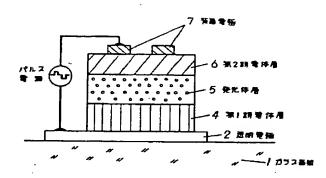
(0) 空気筋胸



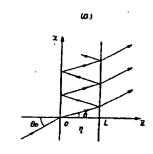
(6) 透明图作的用

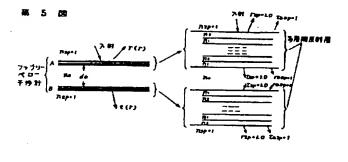


. . .

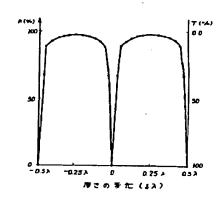


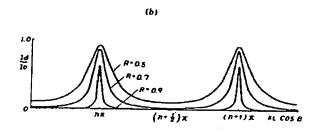
第 4 🔯





第 6 図





特別年3-187186 (6)



